



Electronics for the Future

SMBC日興証券株式会社 個人投資家様向け会社説明会

2024年9月13日
経営戦略本部
広報IR部 IR室

1. 歴史と強み
2. 成長戦略
3. 株主還元
4. SiC事業

1. 歴史と強み
2. 成長戦略
3. 株主還元
4. SiC事業

会社情報 (2024年3月31日現在)

設立年月日
1958年9月17日

従業員数
23,319人

代表者
代表取締役社長 松本 功

グループ会社
国内:6社 海外:30社

売上高
467,780百万円

世界の拠点
海外拠点:76ヶ所 国内拠点:21ヶ所

製品

LSI

アナログ、ロジック、メモリ



半導体素子

トランジスタ、ダイオード、パワーデバイス等



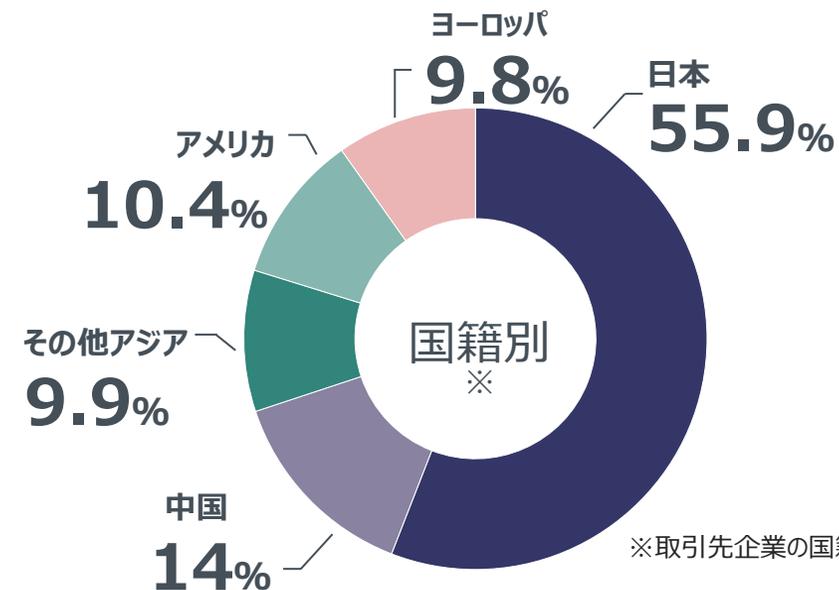
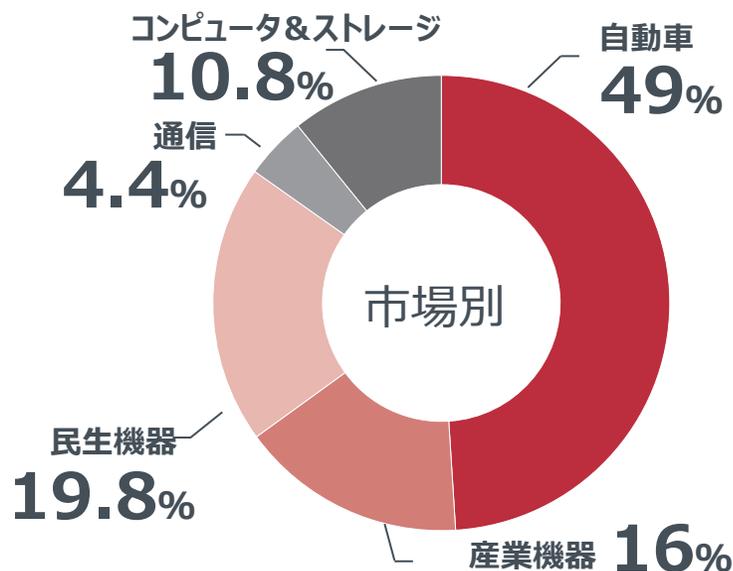
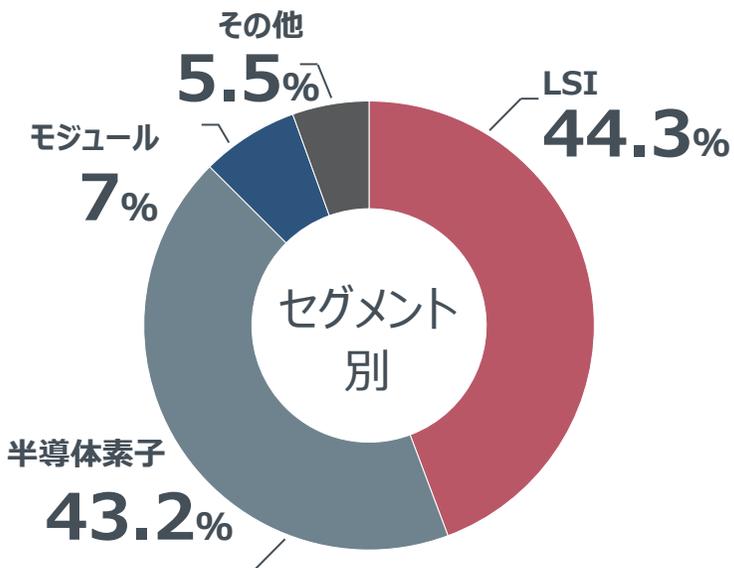
モジュール

プリントヘッド、オプティカル・モジュール



その他

抵抗器など



“Electronics for the Future” エレクトロニクスで社会課題を解決する会社へ

ローム株式会社
代表取締役社長 社長執行役員

松本 功



企業 目的

われわれは、つねに品質を第一とする。
いかなる困難があろうとも、良い商品を国の内外へ永続かつ大量
に供給し、文化の進歩向上に貢献することを目的とする。

ステート メント

Electronics for the Future

ロームは、エレクトロニクスの技術で、社会が抱える様々な課題
を解決し、未来に向けて、人々の豊かな暮らしと、社会の発展を
支え続けていきます。

経営 ビジョン

パワーとアナログにフォーカスし、
お客様の“省エネ”・“小型化”に寄与することで、
社会課題を解決する。

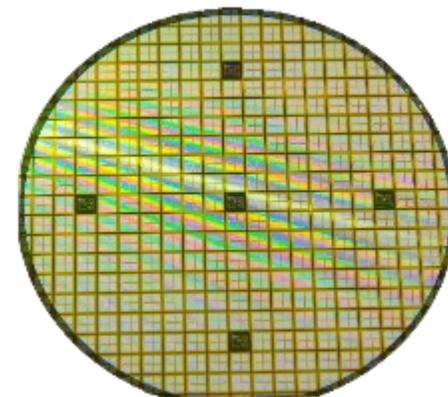
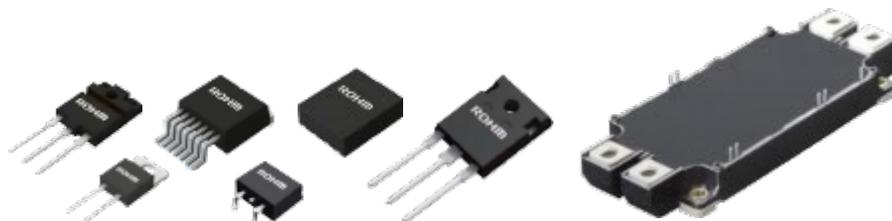
電力をより効率的に扱うため、多彩な技術を駆使したパワーデバイスに注力



半導体の新時代を拓くSiC（シリコンカーバイド）で
パワーデバイスを革新



Si（シリコン）やGaN（窒化ガリウム）など
用途に応じた素材・素子構造で
幅広いアプリケーションに対応



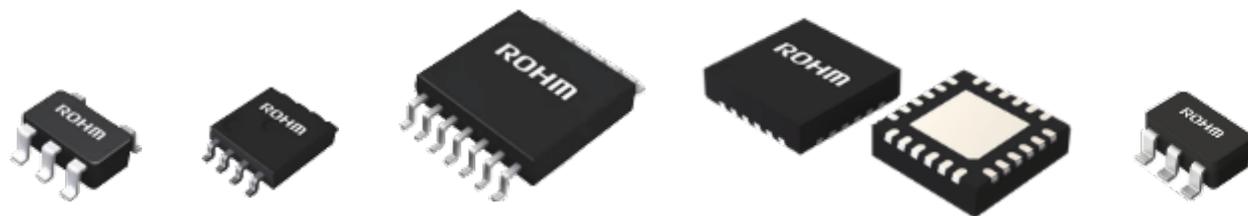
長年培ってきたアナログ技術で時代に応じた最適なソリューションを提供



スマートな機器を動かす、
省エネ・小型化の鍵はアナログIC



進化し続ける革新的な電源技術
精密な制御が可能に

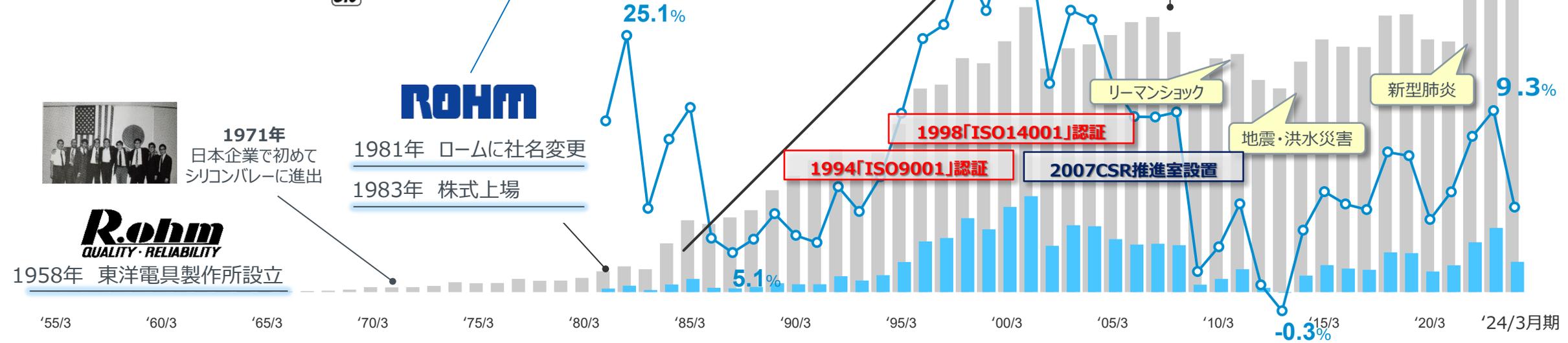


1954年	創業 抵抗器開発・販売	R
1958年	東洋電具製作所設立	
1967年	トランジスタ・ダイオード	Tr Di
1969年	IC	IC
1973年	LED	LED
1981年	ロームに社名変更	
1983年	株式上場	
1984年	半導体レーザー	LD
2010年	SiC	SiC

社名：ROHMの由来
 創業製品である抵抗器(Resistor)の頭文字「R」に抵抗の単位「Ω(OHM)」を組み合わせたもの。「R」は信頼性(Reliability)にも通じており、品質第一とするロームの企業姿勢を示しています。

2008年 新ブランドマーク
 2008年 創立50周年

■ 売上高
 ■ 営業利益
 ○ 営業利益率



原材料からパッケージまで

徹底したトレーサビリティ

品質

開発から製造、販売にいたるまで、全てのプロセスで品質を高める活動に取り組んでいます。

内製材料の
こだわり

Si
シリコン



Wafer



SiC
シリコン
カーバイド

SiCrystal
A ROHM Group Company

SiCrystal社は2009年
ロームグループの一員となった
ドイツのSiC単結晶ウエハメーカー

内製フォトマスク

CAD



Photo
Mask



Wafer Process



内製金型・リードフレーム

Die/Mold



Frame



Assembly
Line



最先端パッケージ

Packaging



Module



ウエハからパッケージまでお客様のニーズに応える

生産システム の自社開発

生産システムを自社で
開発し、お客様のニーズに
きめ細かくお応えしています。

安心の長期安定供給を約束

安定 供給

お客様に安心して商品をお使いいただけるよう
長期安定供給を実施しています。

*Integrated Device Manufacturer

主な生産拠点における各セグメントとの関連

基本的に、ウエハ工程は日本国内拠点、
組立工程は海外拠点が担う



主な海外拠点

ROHM Integrated Systems
(Thailand) Co., Ltd. (タイ)

IC Tr Di SiC IGBT IPM SR Wm



ROHM Electronics
Dalian Co., Ltd.
(大連)

CS SR R



ROHM Electronics (Malaysia)
Sdn. Bhd. (マレーシア)

Tr Di IEP



ROHM Semiconductor
(China) Co., Ltd
(天津)

Di IEP LP SDP



ROHM Electronics Philippines, Inc.
(フィリピン)

IC S Tr Di R R



ROHM Korea Corporation
(韓国)

Tr Di SiC IGBT



SiCrystal GmbH (ドイツ)

SiC

※ウエハ製造



主な国内拠点



ラピスセミコンダクタ
(宮城)

IC



ローム浜松
(静岡)

IC IEP



滋賀工場

Tr Di IGBT



京都本社

IC Tr SiC IEP LP



ローム・ワコー
(岡山)

IC Di IEP LP



ローム・アポロ
(福岡)

IC Tr Di SiC R



ラピスセミコンダクタ
(宮崎)

IC Di SiC IGBT

1. 歴史と強み
2. 成長戦略
3. 株主還元
4. SiC事業

中期経営計画の進捗

中期経営計画(MOVING FORWARD to 2025)

2021年度～2025年度

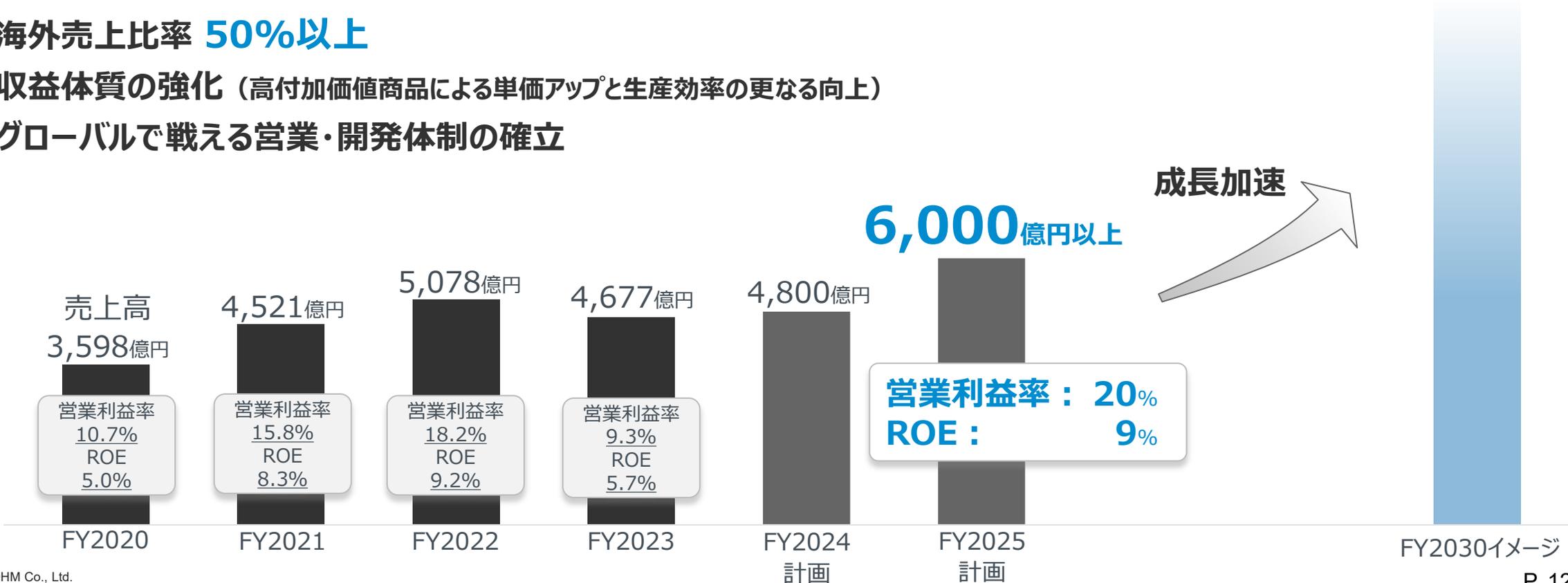
2030年度

"車載" "海外" での成長実現と更なる成長に向けた基盤作り

グローバルメジャーへ

- 成長軌道へ戻す5年
- 電動車市場でグローバルトップシェア商品の確立 (SiC、絶縁ゲートドライバ)
- 海外売上比率 **50%以上**
- 収益体質の強化 (高付加価値商品による単価アップと生産効率の更なる向上)
- グローバルで戦える営業・開発体制の確立

パワー・アナログ分野で世界Top10
 全社売上1兆円を目指す



財務目標

売上高 **6,000**億円以上

営業利益率 **20%**以上

ROE **9%**以上

非財務目標 (抜粋)

環境 (2030年度)

- 温室効果ガス排出量**50.5%**削減 (2018年度比)
- 再生可能エネルギー
2050年度導入比率100%へ向け推進
- 廃棄物ゼロエミッション化

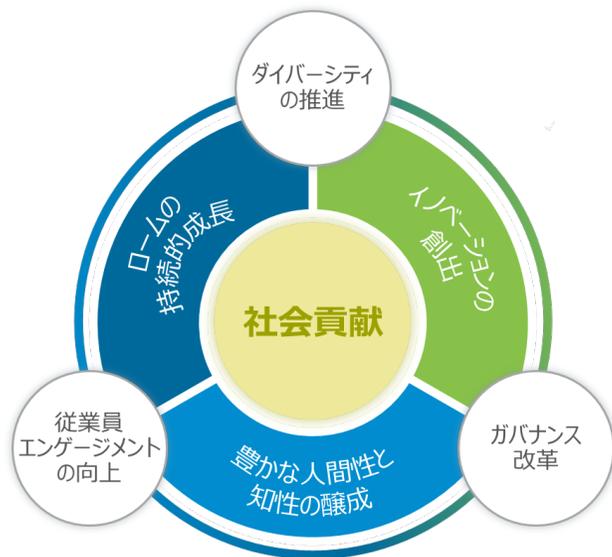
ダイバーシティ、従業員

- グローバル女性管理職比率15%
- 従業員エンゲージメントスコア業界平均以上

お客様

品質満足度スコア+10%改善 (2020年度比)

豊かな人間性と知性を磨いた多様な社員が、高いエンゲージメントを維持し、継続的にイノベーションを創出
実効性のあるガバナンス改革と併せ、企業の持続的な成長を実現



■ 従業員エンゲージメントの向上

- エンゲージメントサーベイの実施
- 組織風土改革、働き方改革推進

2025年度目標

- エンゲージメントスコアで下記を達成
- 毎年のスコア改善
 - 業界平均以上
 - グループ全体で導入完了

2023年度結果

- 業界平均以上達成
- グループ全体で導入完了

■ ダイバーシティの推進

- 女性のキャリア形成促進
- 女性、外国人のマネジメント層への登用

2025年度目標

- グローバル女性管理職比率15%
- 女性または外国人の本社役員比率10%

2023年度結果

- グローバル女性管理職比率
12.6% → **13%**
- 女性または外国人の本社役員比率
23%
女性取締役比率 **15%** + 外国人取締役比率 **8%**

■ ガバナンス改革

- 独立社外取締役の比率の更なる引き上げ
- 中期経営計画に連動した報酬制度導入

2023年度結果

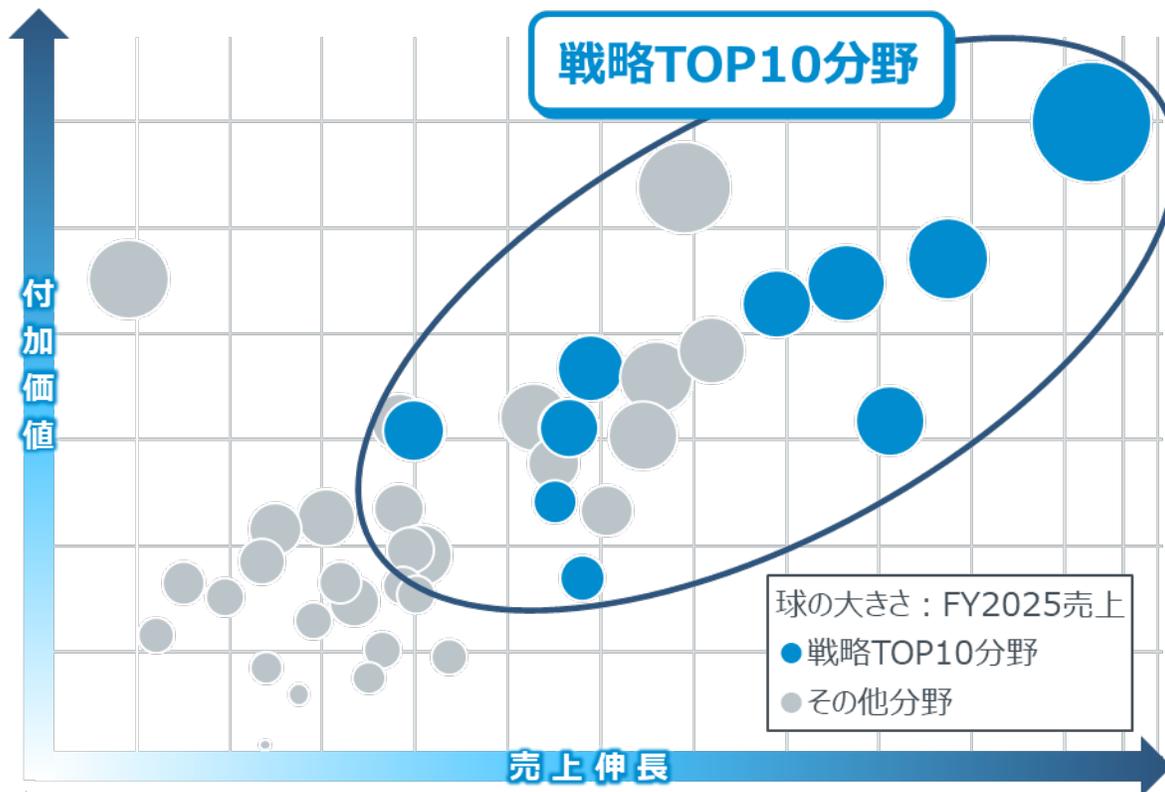
- 独立社外取締役比率**54%**
- 報酬構成や取締役の当社株式保有に対するあり方について協議を継続



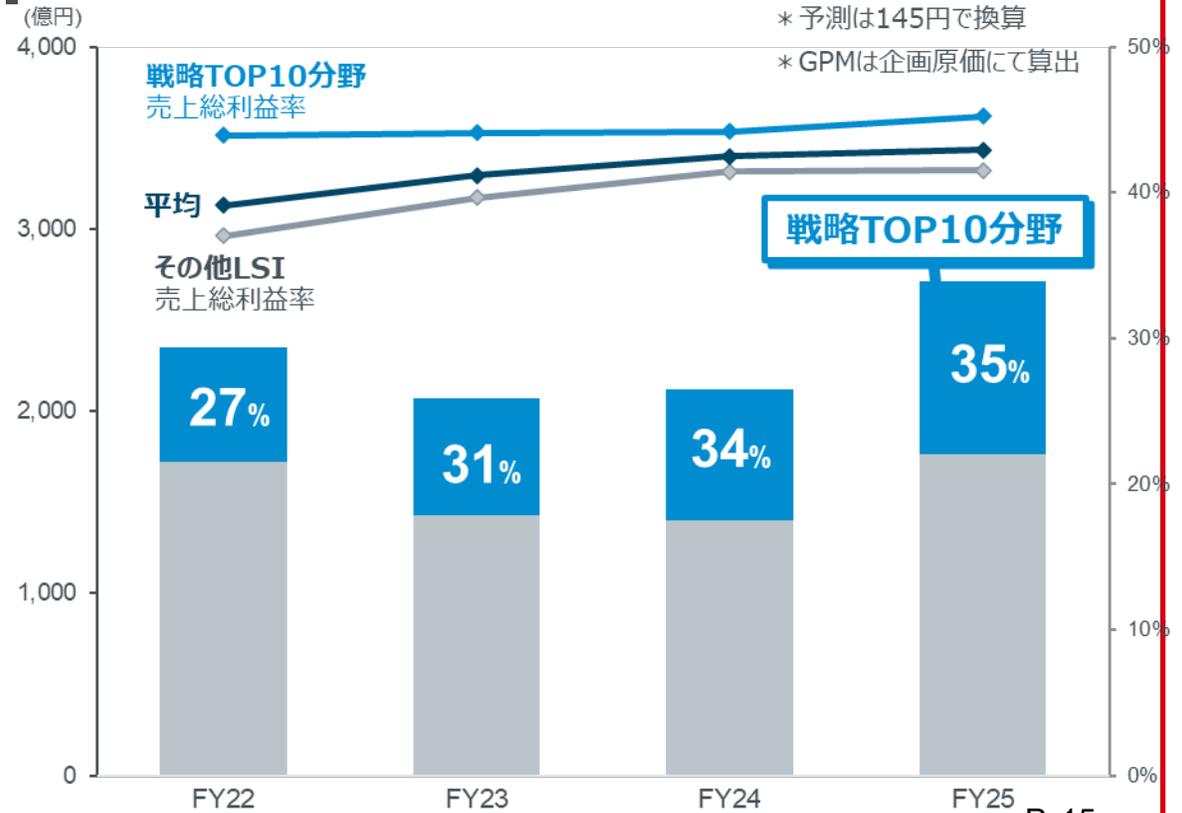
ASSP製品においては戦略TOP10分野を開発・サポート拡充

売上伸長・付加価値のあるASSP分野のTOP10を戦略TOP10分野とし、戦略TOP10分野の売上構成比を上げ、売上・利益拡大を図る。

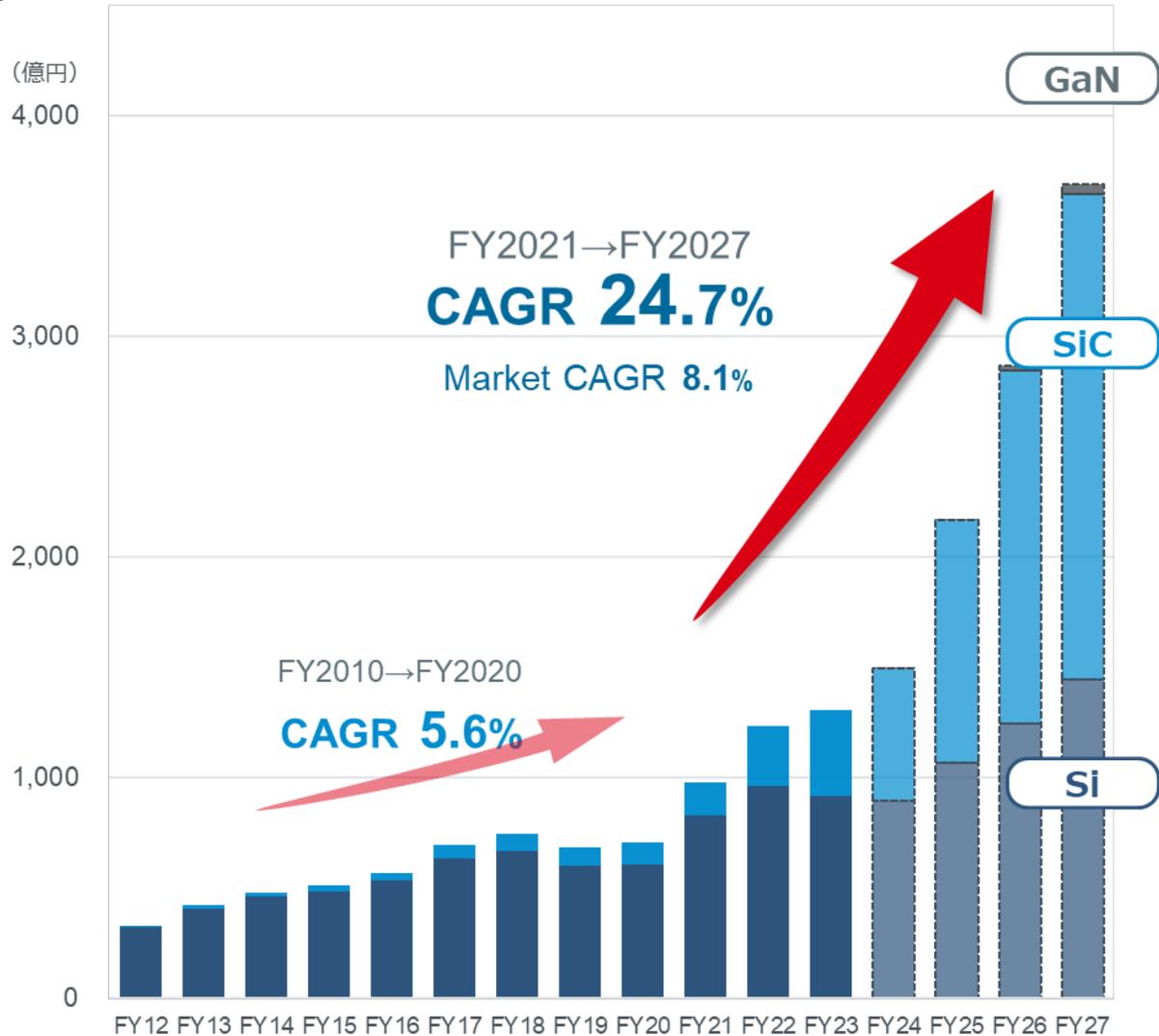
ポートフォリオ（戦略TOP10分野）



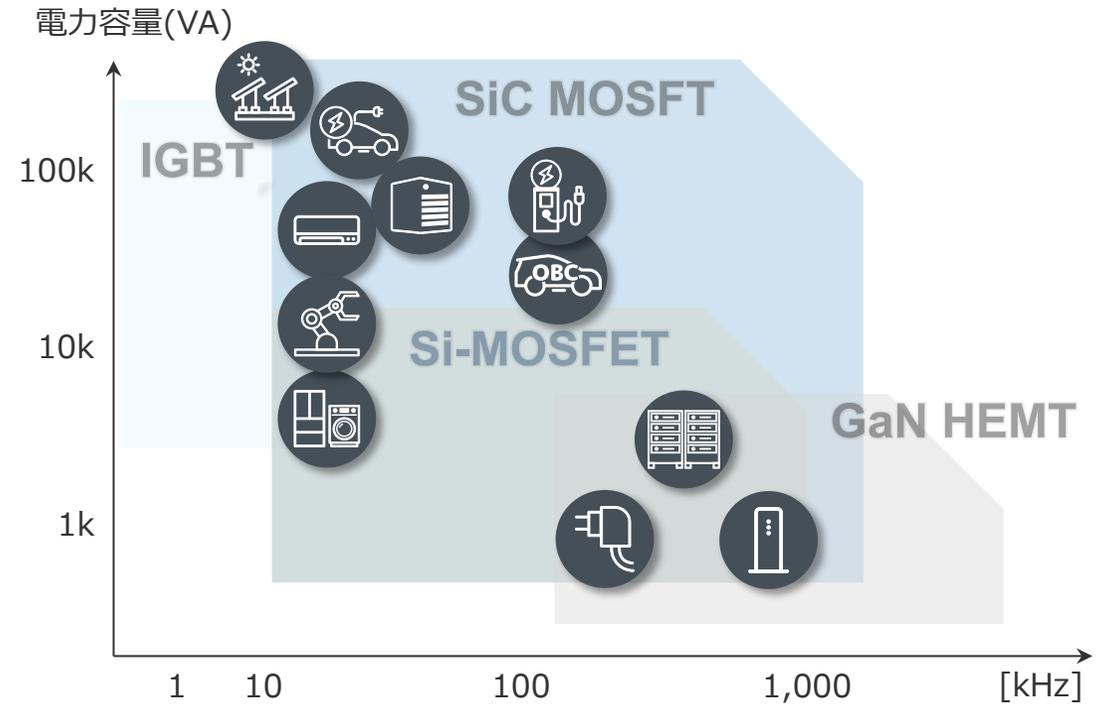
売上比率・売上総利益率（戦略TOP10分野）



パワーデバイス事業の売上目標



パワーデバイスのアプリケーション適用範囲



SiC

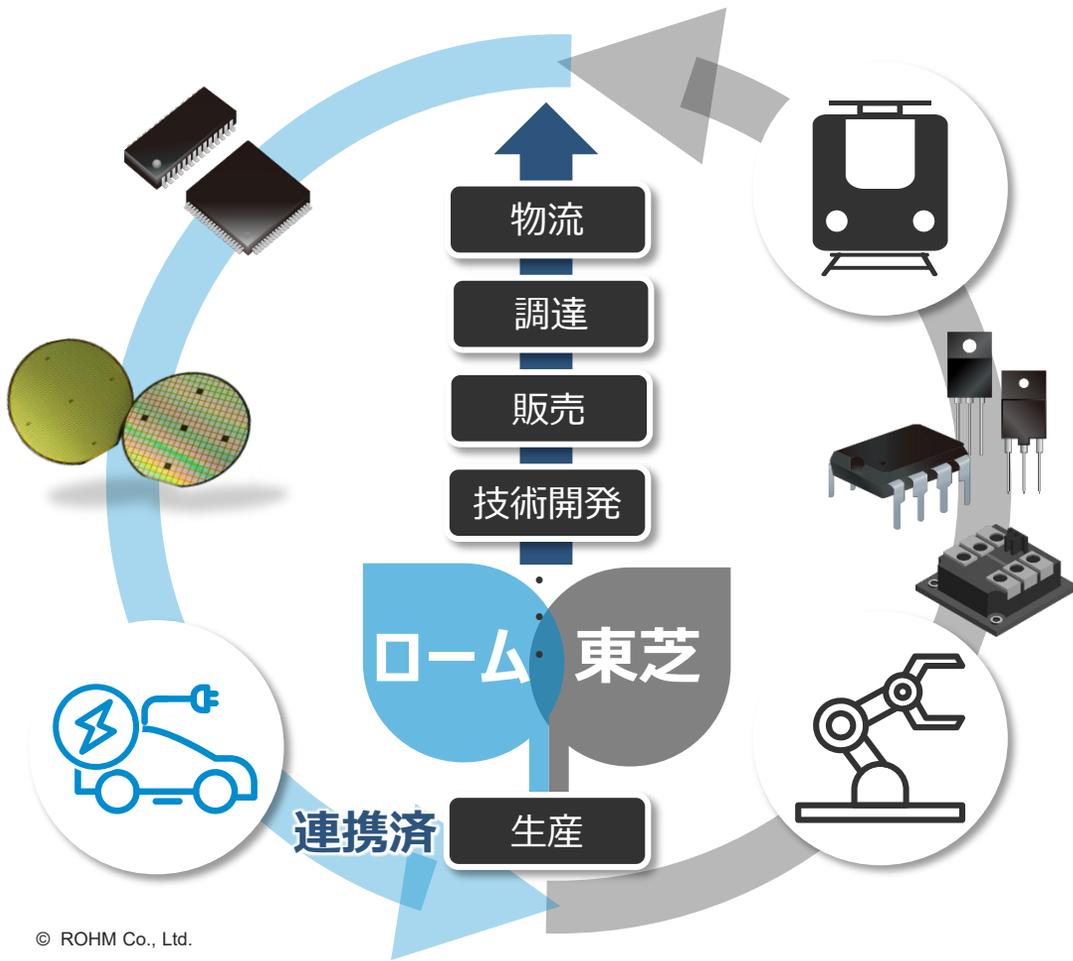
- 大電力
- 高電圧(> 600V)
- 高周波(20~200kHz)

GaN

- 中電力
- 中電圧(100~600V)
- 高周波(200kHz以上)

東芝の半導体事業は、ロームとの親和性が高く、様々なシナジーを創出できる可能性があり、業務提携強化に向けた協議開始の提案を実施 [3月29日公表]

ローム及び東芝双方の企業価値向上を目指す



提案の概要

東芝D&S半導体事業部を中心とした半導体事業に関して、技術開発、生産、販売、調達、物流など、あらゆる事業活動で連携を強化し、両社の企業価値向上を目指すもの。

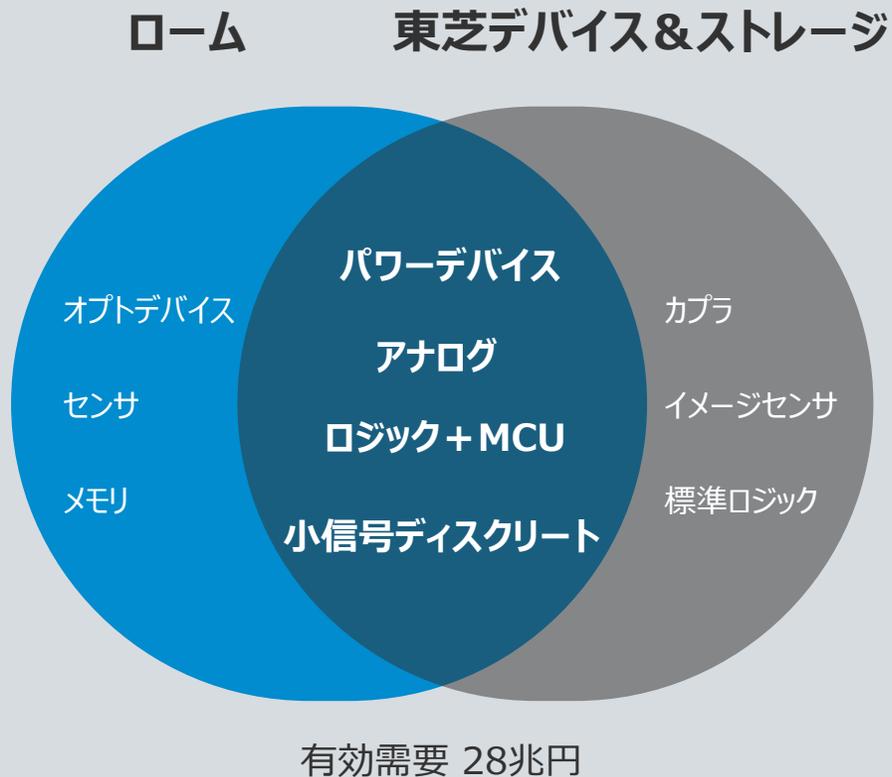
パワー半導体におけるプレゼンスの向上

技術力の強化

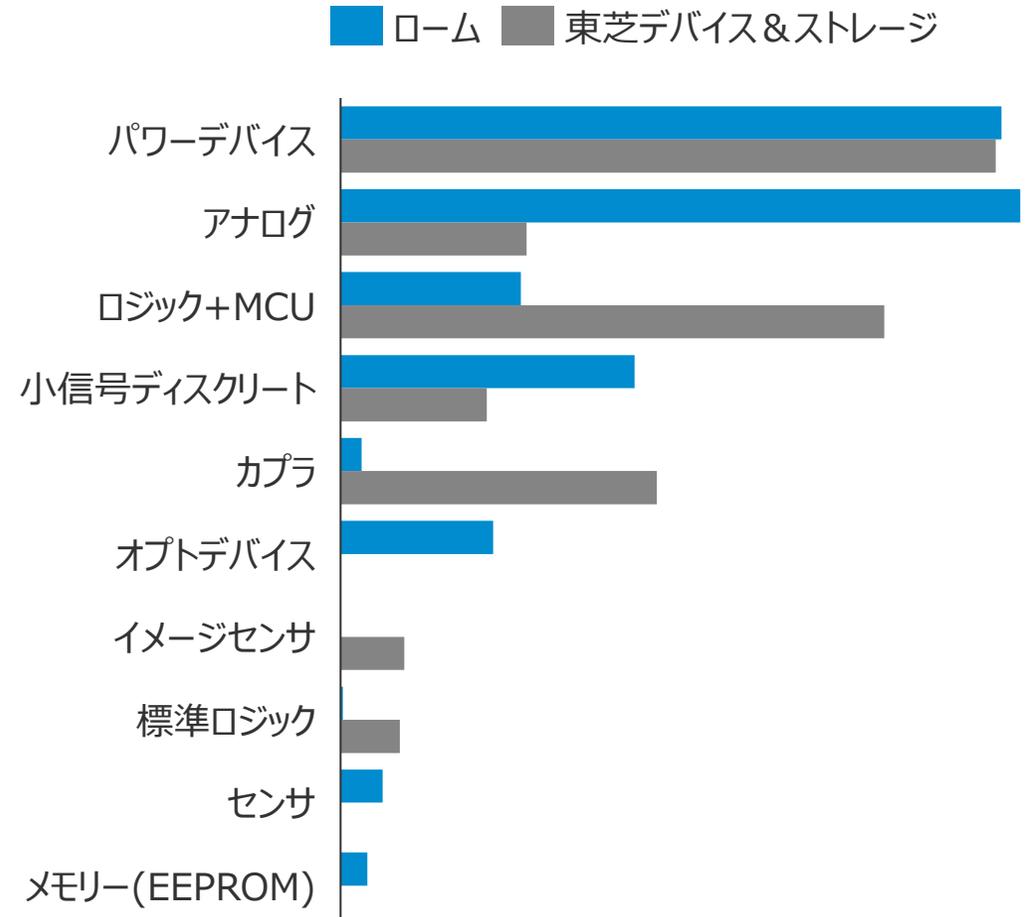
供給力の拡大

6月より業務提携に向けた協議を開始予定

事業領域、また注力製品カテゴリーが近く 親和性が高い

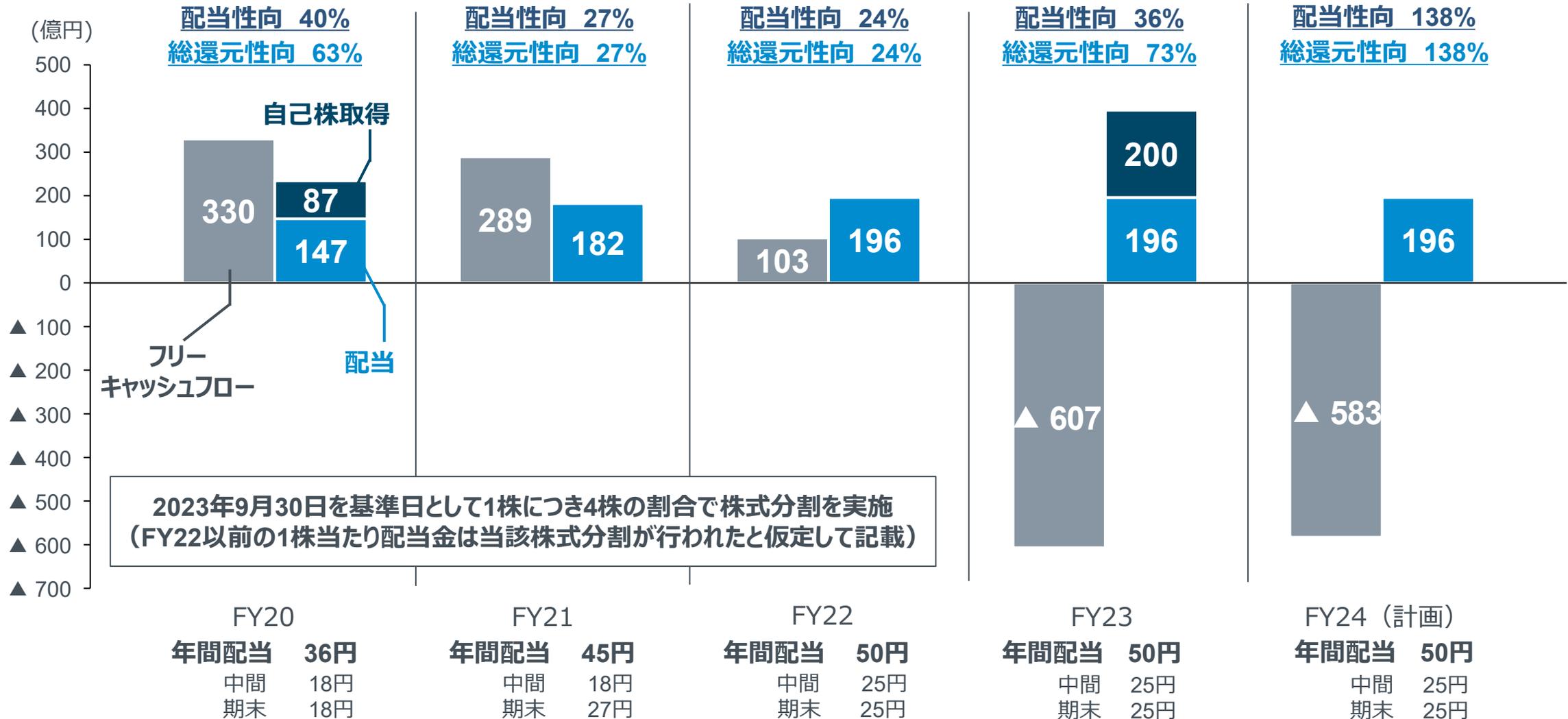


売上高 (2023年)



1. 歴史と強み
2. 成長戦略
- 3. 株主還元**
3. SiC事業

株主還元の推移

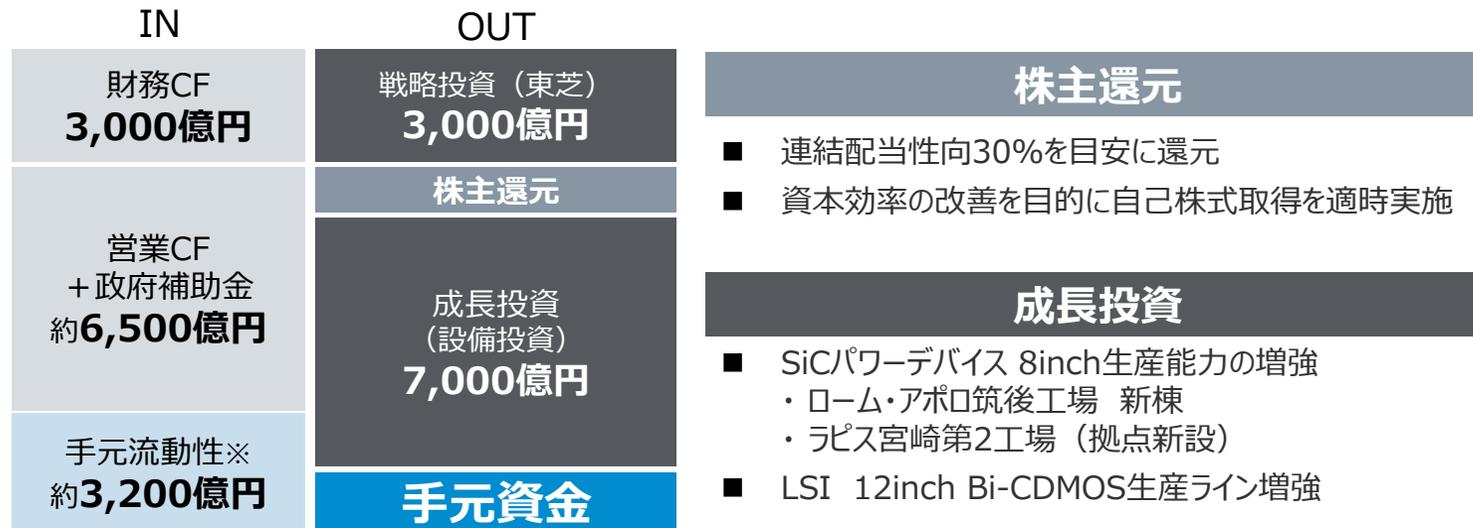


*フリーキャッシュフロー：純利益 + 減価償却費 - 設備投資

財務方針（中計FY21～FY25累計）

- 市況悪化による営業CF減を政府補助金により補填し、成長投資6,000億円を**7,000億円**へ増額
- 3,000億円の資金調達により東芝非公開へ参画。半導体事業における連携強化により企業価値向上を図る
- 転換社債型新株予約権付社債（CB）を発行し、東芝非公開化への参画に際して借り入れたブリッジローンの返済資金の一部に充当
- ブリッジローン残債と'24/12に満期を迎えるCBの額面償還は**手元資金または負債性調達**（銀行借入、社債）で充当
- 株主還元方針は変更なし
- 手元資金の活用を加速、当初計画 年間売上の1/2以下を**1/3以下へ修正**

キャッシュアロケーション（中計FY21～FY25 5年累計）

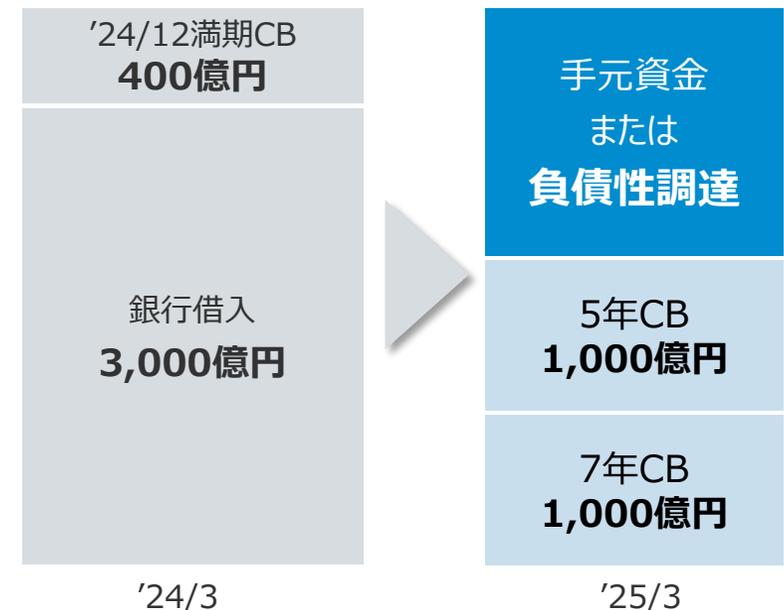


- 連結配当性向30%を目安に還元
- 資本効率の改善を目的に自己株式取得を適時実施

- SiCパワーデバイス 8inch生産能力の増強
 - ・ ローム・アポロ筑後工場 新棟
 - ・ ラピス宮崎第2工場（拠点新設）
- LSI 12inch Bi-CDMOS生産ライン増強

※FY20 期末時点
年間売上の1/3以下

負債に対するファイナンス方針

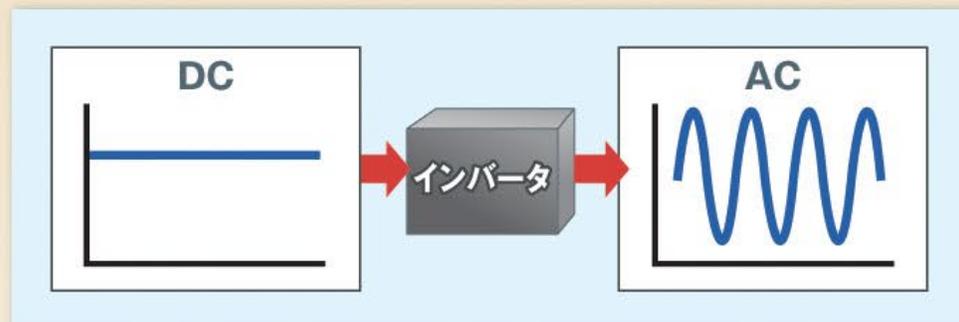


1. 歴史と強み
2. 成長戦略
3. 株主還元
- 3. SiC事業**

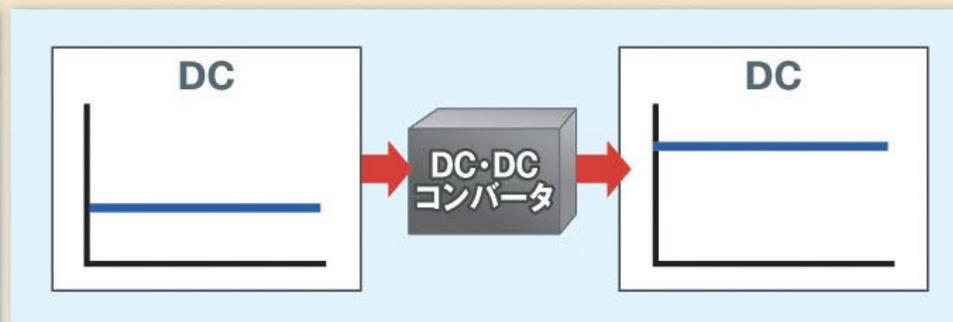
電力を変換する半導体デバイス

→ 電圧、電流、周波数の内1つ以上を変化させること

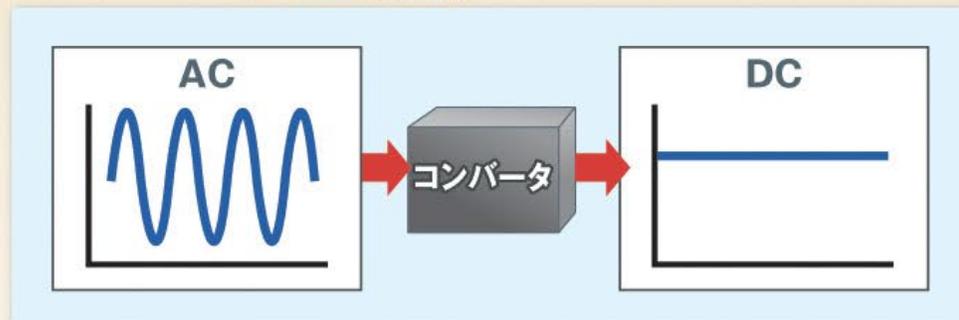
インバータ



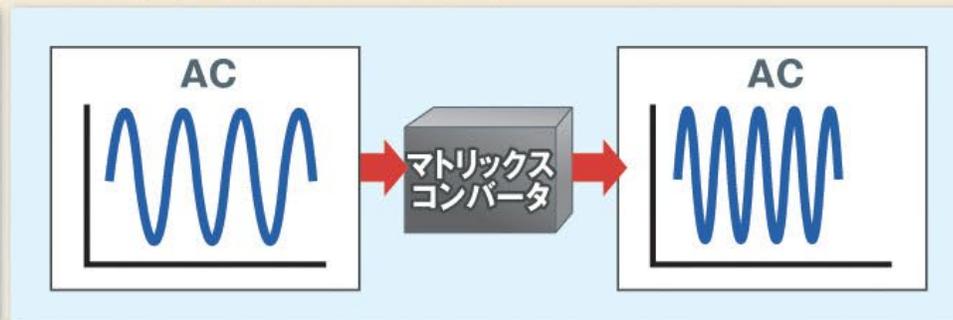
直流チョッパDC/DCコンバータ



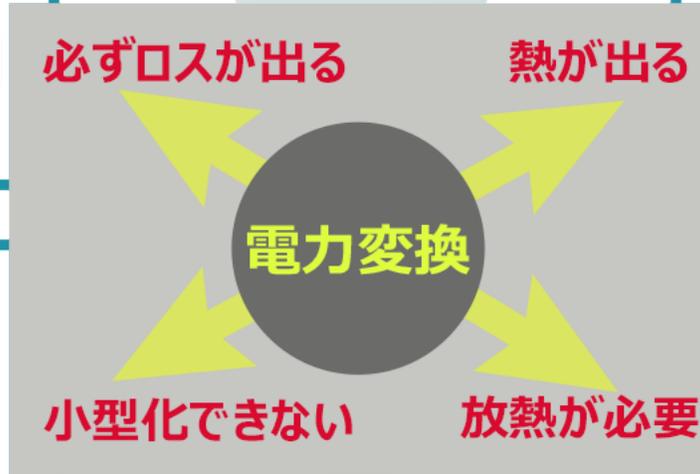
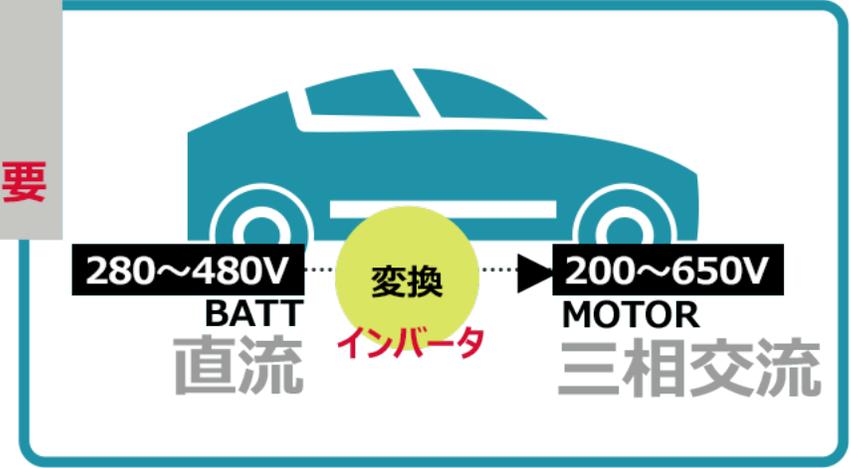
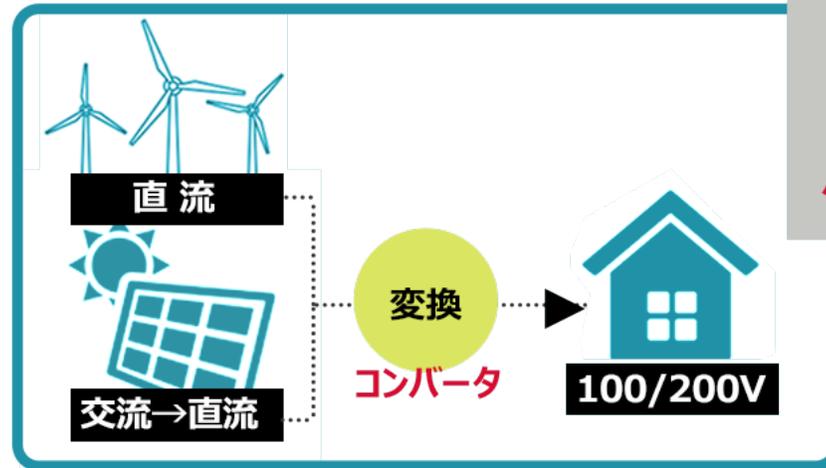
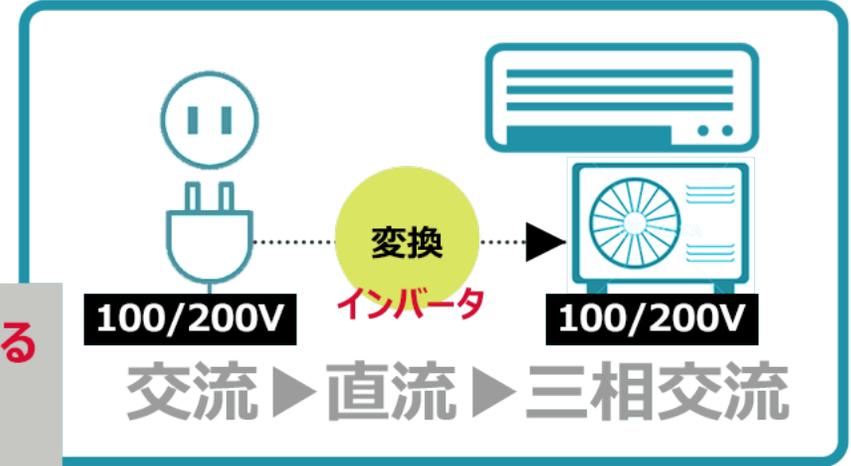
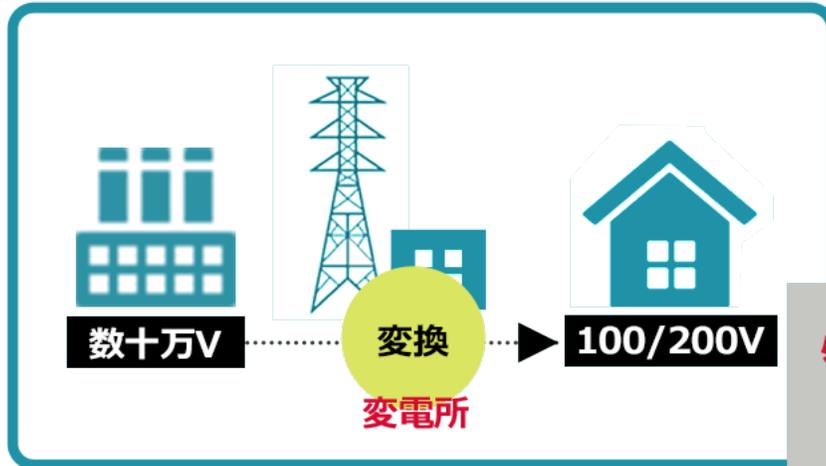
コンバータ (整流器)



マトリックスコンバータ



SiCパワーデバイス 採用のメリット



電力変換時の損失を
大幅に削減

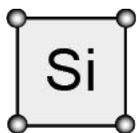
高効率変換

Si-IGBTに比べ、
スイッチング損失を70~90%減
導通損失を50~80%減



SiCパワーデバイス 採用のメリット

従来のシリコンデバイスと比較して



電気抵抗が少ないため



モジュール
小型化

高速動作が可能なので



周辺部品
小型化

高温動作ができるため



冷却機構
簡素化

小型化

走行距離電費テスト結果 (WLTC-3bテスト)

Improved
9.8%



IGBT Case Module 4th Gen SiC Molded Module

高効率化

走行距離電費約5~10%改善



小型軽量化

インバータ・冷却機構・バッテリー

従来のインバータ



SiC採用インバータ



同じバッテリー容量で

▶▶より長距離の走行が可能！

従来のインバータ

Battery 大



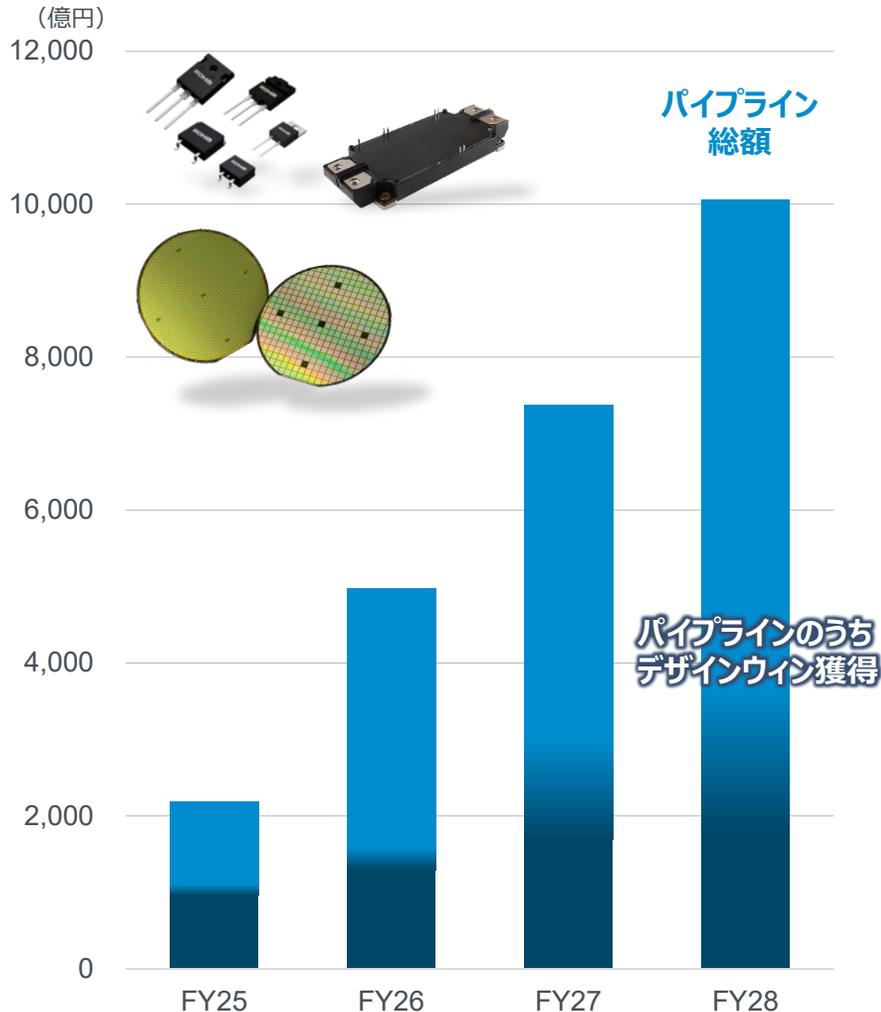
SiC採用インバータ

Battery 小



▶▶より小さなバッテリーで
同じ距離を走行できる！

SiC事業のパイプライン（新規+既存）



SiC事業の目標

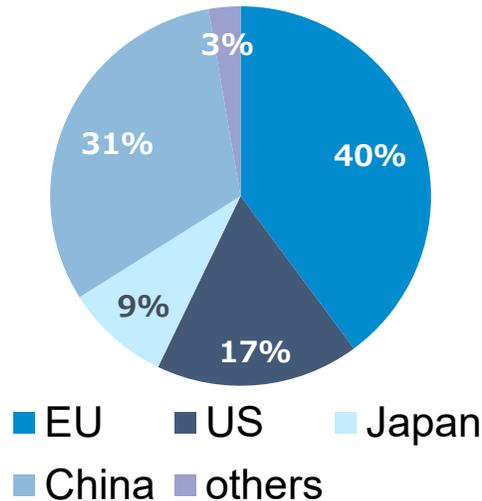
売上目標

> 1,100億円 (FY2025) > 2,200億円 (FY2027)

* 145円で換算

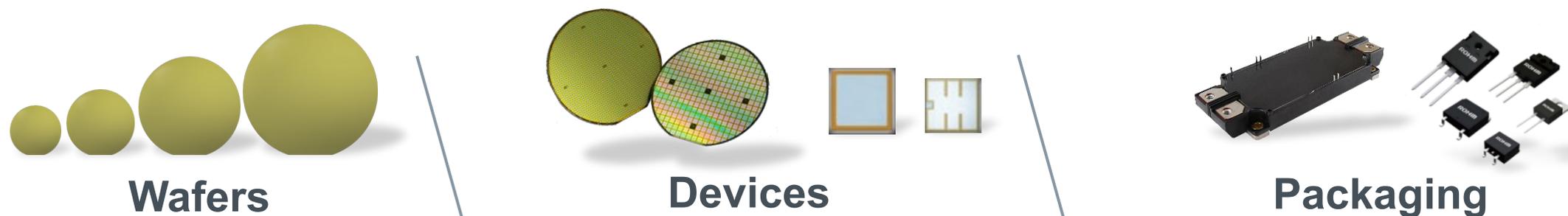
ワールドワイドでバランスよく、
すでに130社以上でデザインウィンが確定

2027年（金額ベース）



地域	DW獲得社数
欧州	24
米州	14
日本	43
中国	39
その他	18

高品質・安定供給・競争力の源泉として、材料～パッケージまでの一貫生産体制を構築



Vertical Integrated SiC Manufacturing



SiCrystal GmbH (ROHM Group)

ドイツ、ニュルンベルク



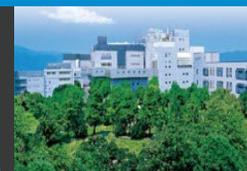
ROHM Apollo

筑後工場



LAPIS Semiconductor

宮崎工場



Kyoto HQ

京都本社



ROHM Korea

韓国



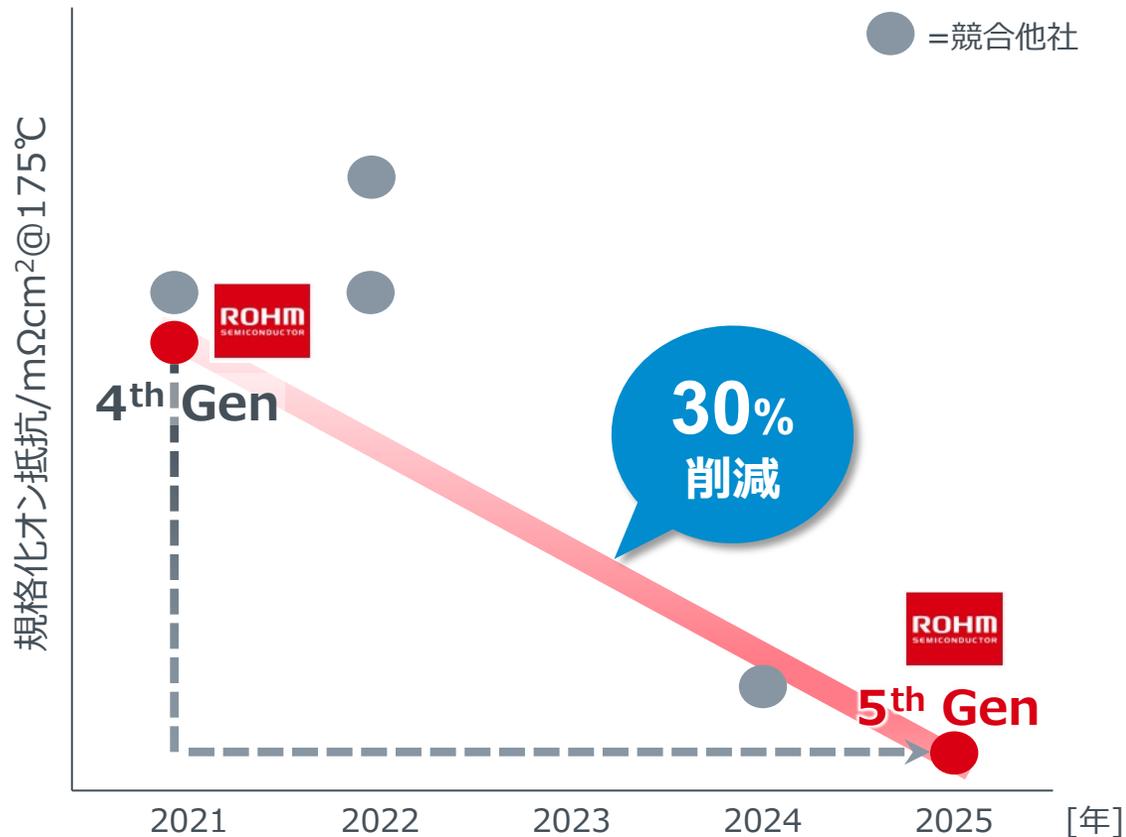
ROHM Integrated System Thailand

タイ

第5世代SiC-MOSデバイスを8インチ基板で生産することで、競争力を大きく向上させる

1200V MOSFETベンチマーク

第5世代MOSFETは高温時のオン抵抗を現行世代比**30%削減**



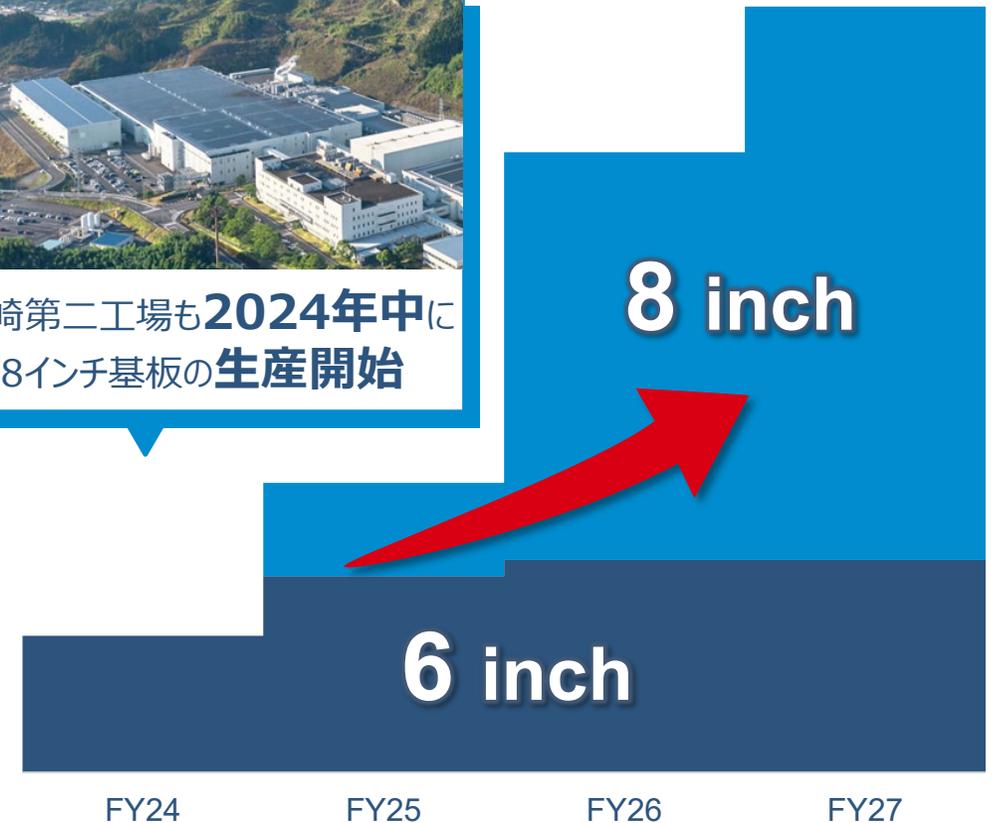
プロット：リリース時期と性能を示す

8インチ化

筑後工場 8インチラインにて**2025年より供給開始**



宮崎第二工場も**2024年中**に
8インチ基板の**生産開始**





Electronics for the Future